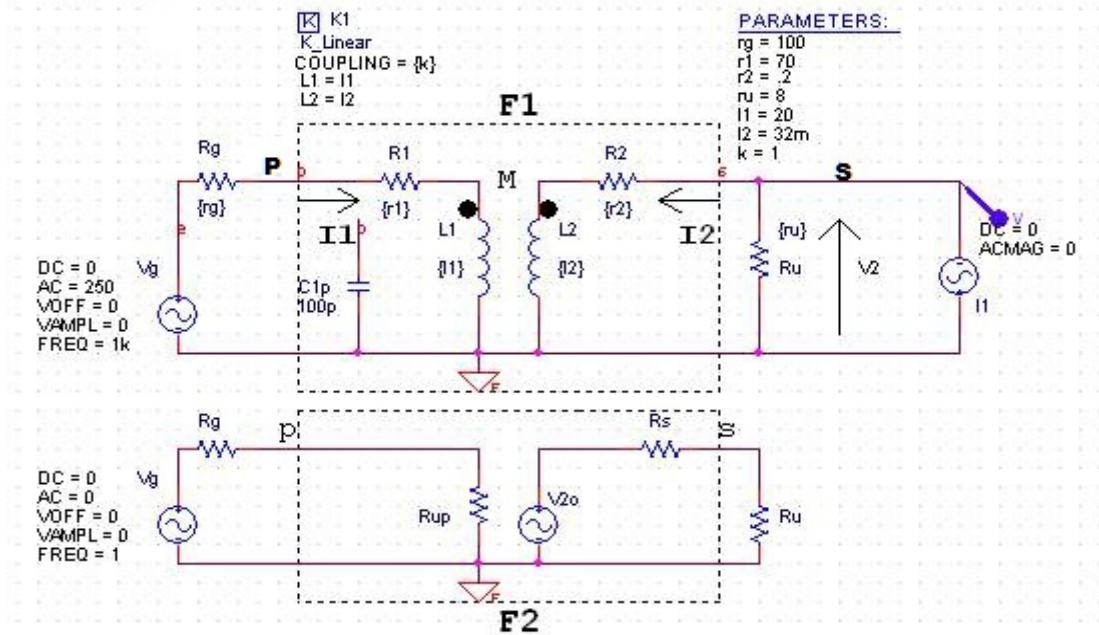


Transformateur utilisé en large bande

Étude du comportement d'un transformateur attaqué par une source de puissance modélisée par un générateur de Thévenin et chargé par un résistor **Ru** de résistance **ru** (impédance **zu**).

Le modèle utilisé (mutuelle inductance) suppose que la saturation magnétique n'est pas atteinte (ce qui est la moindre des choses), et que la perméabilité magnétique peut être admise comme assez constante (ce qui est le plus discutable !).

Schémas utilisés pour les études et simulations



Remarques : Sur le schéma structurel de simulation en **F1** apparaît un condensateur **C1p** entre l'entrée **P** et masse de capacité arbitraire 100pF. Il représente la capacité d'un condensateur *réparti* entre spires de l'inducteur primaire. Il n'interviendra pas dans les expressions suivantes car on pourra l'intégrer au générateur d'attaque. En conséquence la tension d'attaque considérée est **Vp** entre **P** et la masse.

Paramètres intervenants :

***Vp, V2, r1, l1, l2, r2, k** coefficient de couplage avec $M = k \cdot \sqrt{l_1 l_2}$ et $0 \leq k \leq 1$, et **ru (zu)**.

Expressions de base pour décrire le comportement électrique du transformateur :

Voir sur la figure **F1** les grandeurs utilisées et servant aux simulations :

- 1) $V_p = (r_1 + j l_1 \omega) I_1 + j M \omega I_2$ maille primaire
- 2) $V_2 = j M \omega I_1 + (r_2 + j l_2 \omega) I_2 = -r_u I_2$ maille secondaire
- 3) $0 = j M \omega I_1 + (r_2 + r_u + j l_2 \omega) I_2$ on élimine **V2** par introduction de **ru** dans 2)

Dans toute la suite j'utilise la notation symbolique de Laplace $s = j \omega$ ceci pour obtenir une synthèse des impédances par combinaisons d'éléments simples à effet purement résistif, inductif ou capacitif ($r, l, \frac{1}{cs}$).

A) Impédance de charge vue par le générateur d'attaque

C'est **Rup** que présente le transformateur chargé par le résistor (impédance **zu**) **Ru** entre les points **S** et masse (voir **F2**). Pour cela, utilisons 1) et 3) pour exprimer **I2** en fonction de **I1**. On a donc en notation symbolique :

$$0 = M s I_1 + (r_2 + r_u + l_2 s) I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{-M s}{(r_2 + r_u + l_2 s)} I_1 \quad \text{Pour simplifier les écritures, je pose } r_u + r_2 = r_s$$

On porte l'expression de **I2** dans 1) pour obtenir **Vp** en fonction de **I1**, il vient alors :

$$V_p = (r_1 + l_1 s) I_1 - \frac{M^2 s^2}{(r_s + l_2 s)} I_1 = \frac{(r_1 + l_1 s)(r_s + l_2 s) - M^2 s^2}{(r_s + l_2 s)} I_1 = \left(\frac{r_1 r_s + (l_1 r_s + r_1 l_1) s + l_1 l_2 s^2 - k^2 l_1 l_2 s^2}{(r_s + l_2 s)} \right) I_1$$

On pose en général: $\sigma l_1 l_2 = l_f^2$ avec **lf** inductance de fuite du transformateur et $(1 - k^2) = \sigma$ coefficient de Blondel
La résistance **Rup** (impédance **Zup**) de charge vue par le générateur devient :

$$4) \quad r_{up} = \left(\frac{V_p}{I_1} \right) = \left(\frac{r_1 r_s + s(l_1 r_s + l_2 r_1) + s^2 l_f^2}{(r_s + l_2 s)} \right)$$

a) Décomposition de Rup (Zup) en éléments simples :

Pour simplifier les calculs qui suivent, l'expression de **rup** peut s'écrire sous la forme suivante :

$$r_{up} = \frac{(a s^2 + b s + c)}{(d s + e)} \quad \text{avec} \quad a = l_f^2; \quad b = (l_1 r_s + l_2 r_1); \quad c = r_1 r_s; \quad d = l_2; \quad e = r_s$$

J'utilise alors la division euclidienne suivant les puissances décroissantes de **s** pour décomposer la fraction rationnelle.

$$rup = \frac{a}{d}s + \frac{((\frac{bd-ae}{d}s) + c)}{(ds+e)} = \frac{a}{d}s + \frac{(As+c)}{(ds+e)} = rs_1 + rs_2 \text{ avec } rs_1 = \frac{a}{d}s; rs_2 = \frac{(As+c)}{(ds+e)}; A = \frac{(bd-ae)}{d}$$

Il est clair que rup est la mise en série de l'inducteur L_{fp} d'inductance $l_{fp} = \frac{a}{d} = \frac{\sigma l_1 l_2}{l_2} = \sigma l_1 = (1-k^2)l_1$ avec l'impédance rs_2

L_{fp} est l'inducteur de fuite primaire qui est **d'inductance nulle pour $k=1$** , c'est à dire lorsqu'il n'y a pas de fuite magnétique entre la bobine primaire et la bobine secondaire.

Pour décomposer rs_2 on peut choisir entre la somme de deux impédances **rs_{21} et rs_{22}** (mise en série), ou la somme de deux admittances **y_{21} et y_{22}** (mise en parallèle de deux impédances **z_{21} et z_{22}**). C'est la deuxième forme que je prends **arbitrairement**.

On a alors : $y_{s2} = y_{21} + y_{22} = \frac{1}{z_{21}} + \frac{1}{z_{22}} = \frac{ds+e}{As+c} = \frac{ds}{As+c} + \frac{e}{As+c}$ on déduit $z_{21} = \frac{As+c}{ds} = \frac{A}{d} + \frac{c}{ds}$ et donc que **z_{21} est**

la mise en série d'un résistor R_{21} de résistance $r_{21} = \frac{A}{d} = \frac{(bd-ae)}{d^2} = r_1 + ru_s \frac{l_1}{l_2} - \frac{l_f^2 ru_s}{l_2} = r_1 + ru_s \frac{l_1}{l_2} (1-\sigma)$ soit encore :

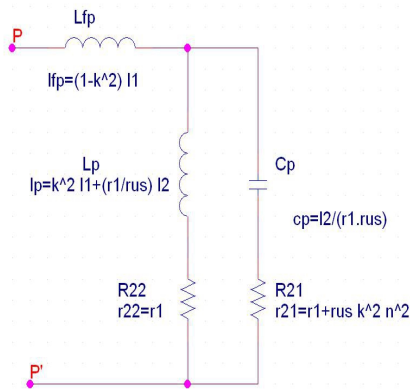
$r_{21} = r_1 + ru_s n^2 k^2$ et $n = \sqrt{\frac{l_1}{l_2}}$ rapport de transformation brut du transformateur, et d'un condensateur **C_p** dont la capacité est

$cp = \frac{d}{c} = \frac{l_2}{r_1 ru_s}$ Remarquons que **si r_1 est nul la capacité devient infinie**, étonnant n'est-il pas !

De même, décomposons $z_{22} = \frac{As+c}{e} = \frac{A}{e}s + \frac{c}{e}$ mise en série du résistor R_{22} de résistance $r_{22} = \frac{c}{e} = r_1$ résistance répartie de la

bobine primaire, et d'un inducteur L_p d'inductance $lp = \frac{A}{e} = \frac{(bd-ae)}{de} = \frac{b}{e} - \frac{a}{d} = l_1 + l_2 \frac{r_1}{ru_s} - \sigma l_1 = k^2 l_1 + \frac{r_1}{ru_s} l_2$

Nous avons tous les éléments simples donnant une modélisation structurelle possible de **Rup** (entre les points P et P').



En résumé on a donc :

l_{fp} inductance de fuite primaire avec : $l_{fp} = (1-k^2)l_1 = \sigma l_1$

lp inductance apparente primaire : $lp = k^2 l_1 + \frac{r_1}{ru_s} l_2 = k^2 l_1$ à vide ($I_2 = 0$)

cp capacité induite ! : $cp = \frac{l_2}{r_1 ru_s}$ influence des résistances primaire et secondaire

r_{22} identique à la résistance primaire r_1

r_{21} résistance totale secondaire ramenée au primaire : $r_{21} = r_1 + ru_s k^2 n^2$

n rapport de transformation brut du transformateur.

Remarques :

*Si on décompose rs_2 par mise en série de deux impédances, on trouve alors pour **Rup** :

L_{fp} ; puis L_p en parallèle avec R_{21} , puis C_p en parallèle avec R_{22} .

Pas possible d'échapper à la cellule **RC**. Je vous laisse le soin de vérifier...

*Si les résistances des enroulements sont proches de zéro ($r_1=r_2=0$) et si pas de fuite magnétique ($k=1, \sigma=0$), alors il reste simplement **L_p** de valeur **l_1** en parallèle avec **R_{21}** de valeur **$n^2 r_1$**

*N'oublions pas de placer entre **P** et **P'** la capacité répartie du primaire **C_{1p}** qui peut influencer la tension effective d'attaque si **R_g** n'est pas négligeable (ce qui est le cas le plus général).

*Les impédances de source et de charge, **$R_g(Z_g)$ et $R_u(Z_u)$** sont considérées comme purement résistives

Il reste à déterminer le générateur de puissance (thévenin) d'attaque de la charge dipolaire **$R_u (Z_u)$** .

B) Générateur équivalent vu par la charge $R_u (Z_u)$.